

# 日程表 (会場別1)

会場名	収容人数	3月22日(金)		3月23日(土)		3月24日(日)		3月25日(月)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
		1BB	120			9:30 ~ 11:45 12.1 作製・構造制御	13:30 ~ 18:45 12.2 評価・基礎物性	9:00 ~ 12:00 KS.1 固体量子センサ研究会	13:30 ~ 18:15 KS.1 固体量子センサ研究会
1BC	120	11:00 ~ 12:00 表彰式	16:00 ~ 18:00 表彰式	9:00 ~ 12:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:30 ~ 19:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	9:00 ~ 12:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:30 ~ 19:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	9:00 ~ 12:00 12.2 評価・基礎物性	13:30 ~ 16:30 12.2 評価・基礎物性
1BJ	135	9:00 ~ 11:45 10.5 磁場応用	13:30 ~ 16:50 T14 磁場を利用した分析技術の最前線 17:15 ~ 18:00 10.5 磁場応用	9:00 ~ 11:45 3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス	13:30 ~ 16:45 10.3 スピンデバイス・磁気メモリストレージ技術		13:30 ~ 17:45 T11 Beyond Graphene	9:00 ~ 11:30 CS.6 6.1 強誘電体薄膜, 13.3 絶縁膜技術, 13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェアセッション	13:00 ~ 14:45 CS.6 6.1 強誘電体薄膜, 13.3 絶縁膜技術, 13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェアセッション
1BL	135	9:00 ~ 11:30 チュートリアル (二次元材料のモアレ物性科学の基礎)	13:30 ~ 18:00 T16 フュージョンエネルギーはカーボンニュートラル実現の鍵となるか?	9:15 ~ 11:50 3.7 光計測技術・機器	13:30 ~ 18:10 T23 応用電子物性分科会設立80周年記念シンポジウム		13:30 ~ 18:00 T7 ハイブリッド材料・システムによる革新的光・スピン計測	9:00 ~ 12:00 12.7 医用工学・バイオチップ	13:30 ~ 16:40 T2 [一般公開]放射線教育・市民科学に向けた検出器開発
1BM	135	9:30 ~ 12:00 チュートリアル (有機ELのデバイス物理: 最先端有機ELディスプレイを理解するための基礎)	13:30 ~ 17:15 T17 [一般公開]ナノテクノロジーを駆使したバイオセンサ最前線 - ヒト感染性ウイルスを迅速に検出可能な グラフェンFET センサ-によるパンデミックのない社会の実現 -	9:00 ~ 12:00 12.7 医用工学・バイオチップ	13:30 ~ 18:00 12.7 医用工学・バイオチップ	9:00 ~ 12:00 12.7 医用工学・バイオチップ	13:30 ~ 17:05 T19 古くて新しい自己組織化・自己集積化		
1BN	135	9:30 ~ 12:00 3.1 光学基礎・光学新領域	13:30 ~ 17:50 T4 レーザ-改質プロセスの基礎と先端技術	9:00 ~ 11:45 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:30 ~ 17:15 12.6 ナノバイオテクノロジー	9:00 ~ 12:30 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:30 ~ 17:20 T20 ロボテクス・未来医療に向けたバイオデバイス研究の最前線		13:00 ~ 17:00 NT2 [一般公開]若手・氷河期世代・女性研究者の声はどこまで届いているか? ~男女共同参画協会連絡会による大規模アンケートに基づいた要望・提言~
11E	135	9:30 ~ 12:00 CS.5 3.10 フォトニック構造・現象, 3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクスのコードシェアセッション	13:30 ~ 15:30 3.10 フォトニック構造・現象	9:45 ~ 12:15 3.10 フォトニック構造・現象 (旧B.11)	13:30 ~ 16:15 CS.4 3.10 フォトニック構造・現象, 3.12 半導体光デバイスのコードシェアセッション	9:45 ~ 12:15 3.10 フォトニック構造・現象	13:30 ~ 16:00 3.10 フォトニック構造・現象	9:00 ~ 11:45 3.8 テラヘルツ全般	13:30 ~ 16:15 3.8 テラヘルツ全般
11F	135		13:30 ~ 17:45 3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス	9:00 ~ 12:00 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学	13:30 ~ 18:15 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学	10:00 ~ 12:00 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学	13:00 ~ 16:00 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 16:15 ~ 18:45 CS.3 3.10 フォトニック構造・現象, 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション	9:00 ~ 12:00 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学	13:30 ~ 16:00 1.2 教育
12A	120	9:00 ~ 12:00 3.12 半導体光デバイス	13:30 ~ 18:00 3.13 光制御デバイス・光ファイバー	10:00 ~ 11:30 3.2 情報フォトニクス・画像工学	13:30 ~ 16:00 3.2 情報フォトニクス・画像工学				
12B	120		14:00 ~ 16:30 チュートリアル (プラズマプロセスにおけるチャージングダメージ ~ 発生メカニズムから対策まで ~)	9:00 ~ 12:00 3.1 光学基礎・光学新領域	13:30 ~ 17:15 3.1 光学基礎・光学新領域	9:00 ~ 12:15 CS.10 16.2 イナジューバーベスティング, KS.3 半導体グリーンフアブ研究会のコードシェアセッション	13:30 ~ 17:45 CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析, 7.4 イオンビーム一般のコードシェアセッション	9:15 ~ 12:00 3.7 光計測技術・機器	13:30 ~ 17:00 3.7 光計測技術・機器
12C	120		13:00 ~ 18:00 KS.2 量子情報工学研究会	9:00 ~ 11:45 3.3 生体・医用光学	13:30 ~ 17:15 3.3 生体・医用光学	9:00 ~ 9:30 1.1 応用物理一般・学際領域 9:30 ~ 11:45 1.3 新技術・複合新領域	13:30 ~ 16:45 1.5 計測技術・計測標準	9:00 ~ 11:30 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	13:30 ~ 16:00 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境
12D	120			9:00 ~ 12:00 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	13:30 ~ 17:30 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	9:45 ~ 12:30 2.5 放射線誘起蛍光体	13:45 ~ 18:00 2.5 放射線誘起蛍光体	9:45 ~ 12:30 2.5 放射線誘起蛍光体	
12E	120	9:15 ~ 12:00 2.1 検出器デバイス開発	13:30 ~ 17:00 2.1 検出器デバイス開発	9:00 ~ 12:30 1.6 超音波	13:30 ~ 17:00 6.2 カーボン系薄膜	9:30 ~ 12:00 2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術	13:30 ~ 15:00 2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術	9:00 ~ 11:15 2.4 医用応用	13:30 ~ 16:00 2.4 医用応用
12F	120			9:30 ~ 11:45 6.6 プローブ顕微鏡	13:30 ~ 17:15 6.6 プローブ顕微鏡	9:00 ~ 12:00 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	13:30 ~ 15:45 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	9:00 ~ 11:15 6.4 薄膜新材料	
12G	120	9:00 ~ 11:30 8.1 プラズマ生成・診断	14:15 ~ 17:45 8.1 プラズマ生成・診断 17:45 ~ 18:15 8.6 Plasma Electronics English Session		13:30 ~ 17:30 CS.7 6.5 表面物理・真空, 7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション	9:30 ~ 11:45 6.3 酸化エレクトロニクス	13:30 ~ 17:15 6.3 酸化エレクトロニクス		
12H	135	9:00 ~ 11:15 8.4 プラズマサイエンス	13:00 ~ 13:45 8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演 14:15 ~ 17:00 8.4 プラズマサイエンス	9:00 ~ 12:00 6.1 強誘電体薄膜	13:30 ~ 16:30 6.1 強誘電体薄膜	9:00 ~ 11:30 6.1 強誘電体薄膜	13:30 ~ 18:00 6.4 薄膜新材料	9:00 ~ 10:15 6.2 カーボン系薄膜	13:30 ~ 16:45 6.2 カーボン系薄膜
12J	135	9:00 ~ 11:45 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 15:45 13.3 絶縁膜技術	9:00 ~ 12:15 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 16:45 13.5 デバイス/配線/集積化技術	9:15 ~ 11:45 13.8 光物性・発光デバイス	15:45 ~ 18:00 CS.8 8.3 プラズマナノテクノロジー, 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシートのコードシェアセッション	9:00 ~ 12:00 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	
12K	135	9:00 ~ 12:00 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	13:30 ~ 17:30 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	9:00 ~ 11:15 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS-装置技術	13:30 ~ 18:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS-装置技術	9:00 ~ 12:00 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:30 ~ 15:15 13.2 探索的材料物性・基礎物性	9:30 ~ 12:00 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	13:30 ~ 16:00 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス
12L	120			9:30 ~ 12:15 13.9 化合物太陽電池	13:30 ~ 16:15 13.9 化合物太陽電池				
12M	120			9:00 ~ 11:45 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	13:30 ~ 17:00 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス		13:00 ~ 19:00 16.3 シリコン系太陽電池	9:00 ~ 12:00 7.2 電子ビーム応用	13:00 ~ 17:00 7.1 X線技術
12N	120	9:00 ~ 11:45 7.3 微細パターン・微細構造形成技術	13:30 ~ 16:30 15.1 バルク結晶成長	9:00 ~ 11:45 11.3 臨界電流, 超伝導パワープロセッサ	13:30 ~ 17:45 11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	9:30 ~ 11:45 11.1 基礎物性	13:30 ~ 15:45 11.1 基礎物性	9:00 ~ 12:00 11.4 アナログ応用および関連技術	
12P	120	9:00 ~ 12:00 9.1 誘電材料・誘電体		9:30 ~ 11:00 11.1 基礎物性	13:30 ~ 15:30 9.3 ナノエレクトロニクス	9:30 ~ 11:45 11.1 基礎物性	13:30 ~ 15:45 11.1 基礎物性	9:30 ~ 11:45 3.9 光子学物理・技術	13:25 ~ 16:45 3.9 光子学物理・技術
13M	135	9:30 ~ 12:00 3.6 レーザプロセッシング	13:30 ~ 18:15 3.15 Optics and Photonics English Session	9:00 ~ 12:00 3.6 レーザプロセッシング	13:30 ~ 18:15 3.6 レーザプロセッシング				
13N	135	9:00 ~ 11:15 3.5 超高速・高強度レーザー	13:30 ~ 16:15 3.5 超高速・高強度レーザー	9:00 ~ 12:00 3.5 超高速・高強度レーザー	13:30 ~ 15:45 3.5 超高速・高強度レーザー				
13P	135	9:00 ~ 12:00 9.4 熱電変換	13:30 ~ 16:30 9.4 熱電変換	9:00 ~ 11:00 9.4 熱電変換	13:30 ~ 16:30 3.4 レーザ装置・材料	9:00 ~ 10:45 CS.2 3.4 レーザ装置・材料, 3.13 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション	13:30 ~ 17:15 3.1 光学基礎・光学新領域		

# 日程表 (会場別2)

会場名	収容人数	3月22日(金)		3月23日(土)		3月24日(日)		3月25日(月)			
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後		
2号館	21B	120			13:15 ~ 17:00 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	10:00 ~ 11:00 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	13:00 ~ 16:30 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」				
	21C	225	9:45 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 18:00 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 18:15 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00 ~ 11:45 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 15:00 15.4 III-V族窒化物結晶		
	22A	112	9:45 ~ 11:30 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶		9:45 ~ 11:30 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶		9:45 ~ 11:30 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶		9:45 ~ 11:30 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶		
	22B	112			13:00 ~ 16:45 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	9:00 ~ 11:30 12.4 有機EL・トランジスタ	9:00 ~ 11:30 12.4 有機EL・トランジスタ	13:00 ~ 16:45 12.4 有機EL・トランジスタ	9:00 ~ 11:45 12.4 有機EL・トランジスタ		
	22C	225	10:00 ~ 11:40 T18 [一般公開]有機薄膜太陽電池の社会実装に向けて必要なこと:ペロブスカイト太陽電池との共通基盤技術	13:00 ~ 15:45 T18 [一般公開]有機薄膜太陽電池の社会実装に向けて必要なこと:ペロブスカイト太陽電池との共通基盤技術	9:00 ~ 12:00 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	13:00 ~ 16:30 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	9:00 ~ 11:30 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	13:00 ~ 16:30 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	10:00 ~ 11:30 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	13:00 ~ 16:00 CS.9 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池, 13.9 化合物太陽電池, 16.3 シリコン系太陽電池のコードシェアセッション (タンデム)	
3号館	31A	160			9:00 ~ 11:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:00 ~ 17:00 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	9:00 ~ 11:30 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	13:00 ~ 17:00 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	9:00 ~ 11:30 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	13:00 ~ 15:45 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	
	31B	160			9:30 ~ 11:30 17.3 層状物質	13:00 ~ 18:00 17.3 層状物質	9:00 ~ 11:30 17.3 層状物質	13:30 ~ 17:45 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野	9:15 ~ 11:30 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	13:00 ~ 16:30 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	
	32A	120		13:00 ~ 15:45 17.1 カーボンナノチューブ, 他 のナノカーボン材料	9:30 ~ 11:15 17.2 グラフェン	13:00 ~ 14:15 17.2 グラフェン 14:15 ~ 17:30 17.1 カーボンナノチューブ, 他 のナノカーボン材料	9:00 ~ 11:30 17.2 グラフェン	13:30 ~ 17:45 9.5 新機能材料・新物性	9:00 ~ 11:45 9.5 新機能材料・新物性		
5号館	52A	160	9:00 ~ 11:45 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	13:00 ~ 17:45 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	9:00 ~ 11:30 15.6 IV族系化合物 (SiC)	13:00 ~ 18:15 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	9:00 ~ 11:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:00 ~ 18:15 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	9:00 ~ 11:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:00 ~ 14:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	
	61A	204	13:30 ~ 17:30 T1 21世紀の科学者・技術者の育成のあり方 ~ 組織における人材育成・技術伝承 ~		9:00 ~ 11:40 T26 エネルギーハーベスティングのフロンティア - GXに挑戦する若手研究者たち	13:00 ~ 15:10 T26 エネルギーハーベスティングのフロンティア - GXに挑戦する若手研究者たち	9:45 ~ 11:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:30 ~ 17:00 T8 3次元空間光センシングの最前線	9:30 ~ 11:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:00 ~ 16:45 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	
6号館	61B	204	13:30 ~ 17:20 T9 酸化物材料の圧電デバイス応用		9:15 ~ 11:45 NT1 [一般公開]就活生必見! 未来への挑戦状 ~ 先端半導体が拓く未来社会のビジョン ~	13:30 ~ 16:15 T10 バイオミメティクスとセンサー・AI ~ 自然から学び、未来を創る ~	9:00 ~ 11:30 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	13:30 ~ 17:10 T12『運用開始直前企画』ナノテラスの活用をお教えします!	9:15 ~ 11:30 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	13:00 ~ 15:30 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	
	61C	357	9:00 ~ 11:30 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:30 ~ 16:35 T24 IoT市場拡大に資する半導体産業の進展とコア技術とは?	9:00 ~ 11:45 T27 [一般公開]インフォマティクスが明らかにする材料と脳	13:00 ~ 16:35 T27 [一般公開]インフォマティクスが明らかにする材料と脳		13:00 ~ 16:30 T25 深紫外光デバイス進展 16:45 ~ 18:00 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00 ~ 11:45 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	13:00 ~ 16:30 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	
	71A	250	13:30 ~ 17:30 T21 [一般公開]東装技術アカデミー:最先端半導体実装技術の挑戦と将来展望		9:30 ~ 11:15 8.7 プラズマエレクトロニクス分科 内招待講演	13:30 ~ 18:20 T13 プラズマが拓くナノ粒子・量子ドットの展開	9:00 ~ 11:30 3.8 テラヘルツ全般	13:30 ~ 17:00 T6 [一般公開]量子エレクトロニクス研究会 50周年記念シンポジウム	9:00 ~ 11:30 T3 [一般公開]応用物理がもたらすメタバスの臨場感 (第3弾)	13:00 ~ 16:00 T3 [一般公開]応用物理がもたらすメタバスの臨場感 (第3弾)	
71B	252	13:30 ~ 16:45 T22 未来を拓く多元系化合物の様々な機能性と物性		13:30 ~ 18:20 T5 分極反転光材料・デバイスの発展と応用		9:00 ~ 11:30 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス	13:30 ~ 17:25 T15 スピントロニクス実用技術:トンネル磁気抵抗研究とメモリ応用の最前線	9:00 ~ 11:30 17.3 層状物質	13:00 ~ 16:45 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス		
9号館	P		[09:30-11:30] 11 超伝導 12.3 機能材料・萌芽的デバイス 12.6 ナノバイオテクノロジー 12.7 医用工学・バイオチップ	[13:30-15:30] 12.2 評価・基礎物性 12.4 有機EL・トランジスタ 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価 15.6 IV族系化合物 (SiC)	[09:30-11:30] 3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5) 3.5 超高速・高強度レーザー (旧3.6) 3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9) 3.9 光子物理・技術 (旧3.10) 3.13 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.14) 6.3 酸化物エレクトロニクス 6.4 薄膜新材料 7 ビーム応用 FS フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	[13:30-15:30] 2 放射線 12.1 作製・構造制御 13.2 探索的材料物性・基礎物性 13.8 光物性・発光デバイス	[09:30-11:30] (旧3.2)材料・機器光学と統合 3.2 情報フォトニクス・画像工学 (旧3.3) 3.3 生体・医用光学 (旧3.4) 3.6 レーザープロセス (旧3.7) 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8) 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.12) 3.12 半導体デバイス (旧3.13) 3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス (旧3.15) 8.3 プラズマナノテクノロジー 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野 15.1 パルク結晶成長 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	[13:30-15:30] 6.1 強誘電体薄膜 6.2 カーボン系薄膜 6.5 表面物理・真空 6.6 フロー顕微鏡 9 応用物性 13.9 化合物太陽電池 23 合同セッションN「インフォマティクス応用」	[16:00-18:00] 8.1 プラズマ生成・診断 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理 8.4 プラズマライフサイエンス 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.3 絶縁膜技術 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術 13.5 デバイス/配線/集積化技術 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス 21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	[09:30-11:30] 10 スピントロニクス・マグネティクス 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎 15.4 III-V族窒化物結晶 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥 16 非晶質・微結晶 KS 研究会セッション	